

specificazioni	
Modello di prodotti	DMP6180SK3-13
fabbricante	Diodes Incorporated
Descrizione	MOSFET P-CH 60V 14A TO252
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	11236 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	2.7V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	TO-252
Serie	-
Rds On (max) a Id, Vgs	110 mOhm @ 12A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	1.7W (Ta)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	984.7pF @ 30V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	17.1nC @ 10V
Tipo FET	P-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Tensione drain-source (Vdss)	60V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	14A (Tc)

 DMP6180SK3Q-13 Diodes Incorporated MOSFET P-CHANNEL 60V 14A TO252	 DMP6180SK3 DIODES DMP6180SK3 DIODES	 DMP6110SVT-7 MOS DIODES DIODES SOT-163	 DMP6110SVTQ DIODES DMP6110SVTQ DIODES
 DMP6185SE-13 Diodes Incorporated MOSFET PCH 60V 3A SOT223	 DMP6110SVTQ-7 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V TSOT26	 DMP6110SVTQ-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V TSOT26	 DMP6180SK3-13 MOS DIODES DIODES TO-252

Di Più

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited